

性能特点

- 频率范围: 12.5 ~ 16 GHz
- 小信号增益: 28.5dB
- P1dB 输出功率: 34dBm@Vd = +8V
- Psat 输出功率: 34.5dBm@Vd = +8V
- Bias: Vd = 6V, Id = 760mA
Vd = 8V, Id = 820mA
- 芯片尺寸: 2.55mm×1.62mm× 0.1mm

产品简介

ZRA1292D 是一款 Ku 波段功率放大器，采用 GaAs 工艺制造。其工作频率覆盖范围 12.5~16GHz，小信号增益为 28.5dB，饱和输出功率 34.5dBm。

应用领域

- 点对点无线电
- Ku 频段 VSAT

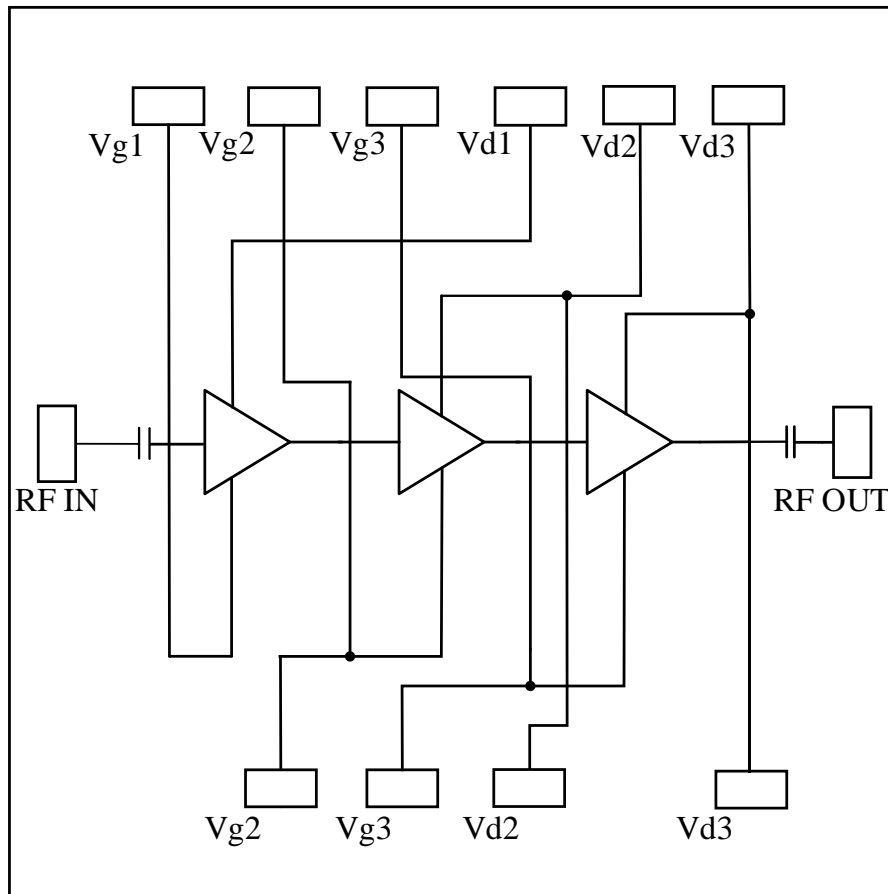


Figure 1. Functional Block Diagram

目录

性能特点.....	1
产品简介.....	1
应用领域.....	1
1. 性能参数.....	3
1.1. 电参数.....	3
1.2. 允许最大参数范围.....	3
1.3. ESD 等级.....	3
1.4. 推荐工作条件.....	3
2. 典型性能特点.....	4
3. 管脚信息.....	6
3.1. 管脚描述.....	6
4. 外形尺寸.....	7
5. 建议装配示意图.....	8
6. 历史版本.....	9

1. 性能参数

1.1. 电参数

除非状态特殊说明，所有参数均在 $V_d = 6V$, $I_d = 760mA$, $T_A = 25^\circ C$ 条件下测试得出。

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
Frequency Range	12.5		16	GHz
Gain	27.8	28.5	29.8	dB
Input Return Loss		10		dB
Output Return Loss		19		dB
Output P1dB@Vd=6V	32	32.4	32.7	dBm
Output P1dB@Vd=8V (CW,reference to small signal gain@max gain point)	33.8	34	34.1	
Saturated Output Power(P_{sat}) @Vd=6V	32.8	33.3	33.4	dBm
Saturated Output Power(P_{sat}) @Vd=8V (CW,reference to small signal gain@max gain point)	34.3	34.4	34.5	
OIP3(POUT/Tone = 23.5 dBm, 5 MHz tonespacing)		37.5		dBm
Gain Temperature Coefficient		TBD		dB/°C
Power Temperature Coefficient		TBD		dB/°C

1.2. 允许最大参数范围

参数名称	参数值 / 范围	单位
Drain Voltage (Vd)	+8.5	V
Gate Voltage Range (Vg)	-4 to 0	V
Drain Current (Id)	1200	mA
Power Dissipation (PDISS)	10	W
RF Input Power,CW, 50Ω,T = 25°C	24	dBm
Junction Temperature	175	°C
Soldering Temperature (30s, max.)	260	°C
Storage Temperature	-65 to 150	°C

以上参数仅表示应力范围，并不意味在这些条件下的功能操作。芯片在以上所列参数范围外工作可能造成芯片永久性损坏。

1.3. ESD 等级

参数名称	参数值	等级
Human Body Model (HBM)	±250V	Class-1A

1.4. 推荐工作条件

Vd(V)	Id(mA)
+5~+8	720 ~ 820

2. 典型性能特点

除非状态特殊说明, 所有参数均在 $V_d = 6V$, $I_d = 760mA$, $T_A = 25^\circ C$ 条件下测试得出。

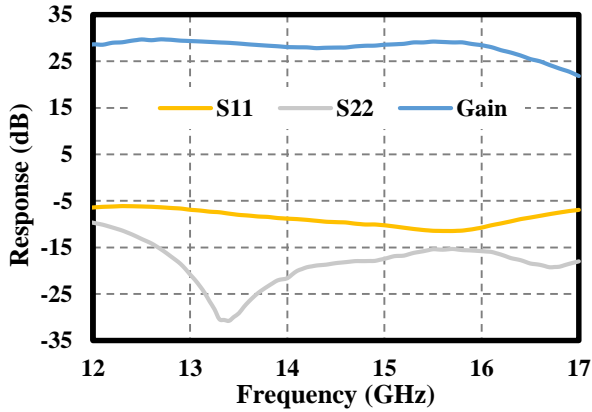


Figure 2. Gain & Return Loss

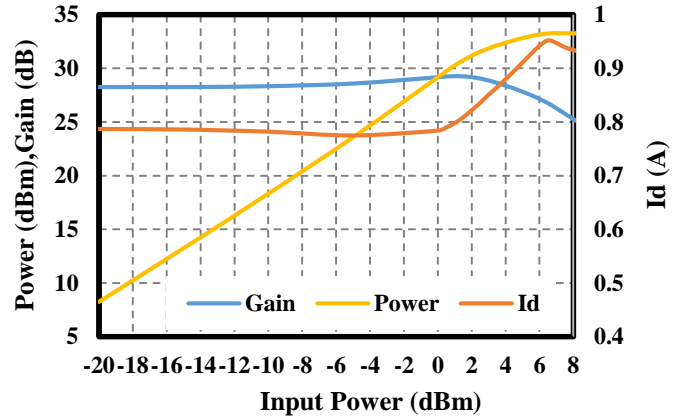


Figure 3. Power, Gain, Id vs. InputPower @ 14 GHz

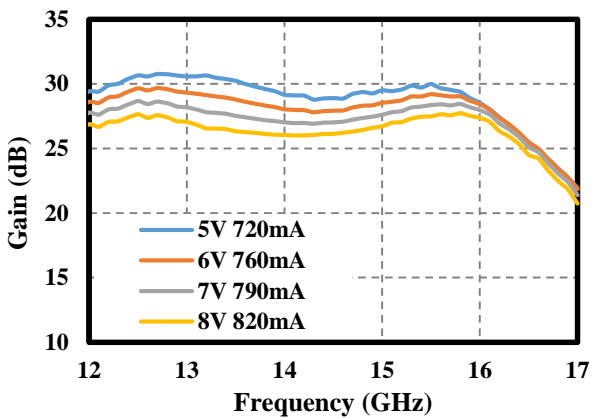


Figure 4. Gain vs. Vd

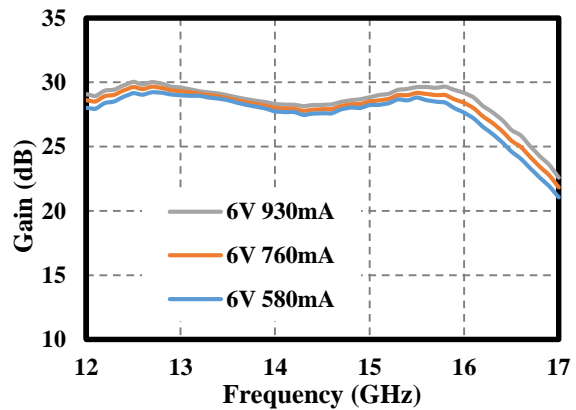


Figure 5. Gain vs. Id

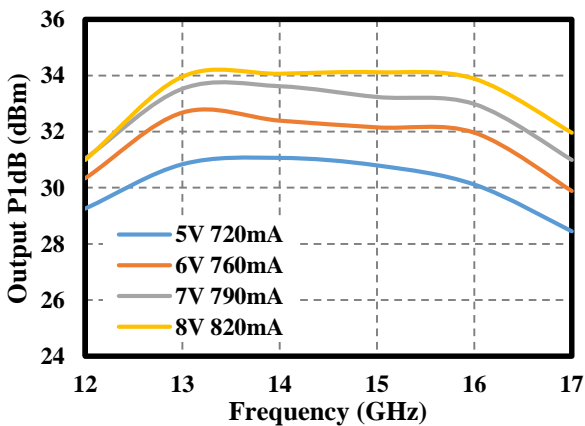


Figure 6. P1dB vs. Vd

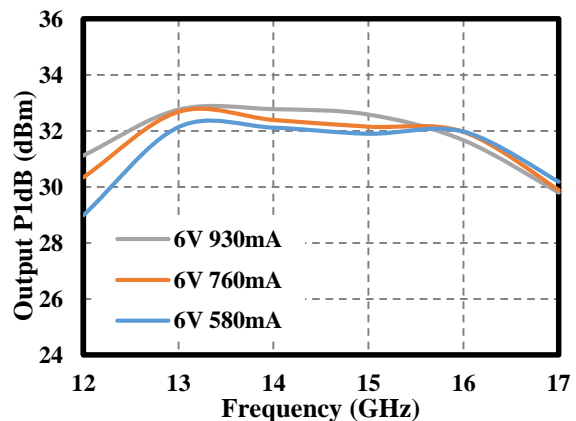


Figure 7. P1dB vs. Id

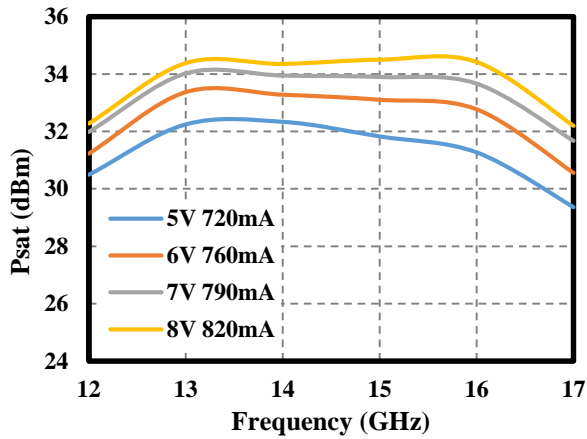


Figure 8. Psat vs. Vd

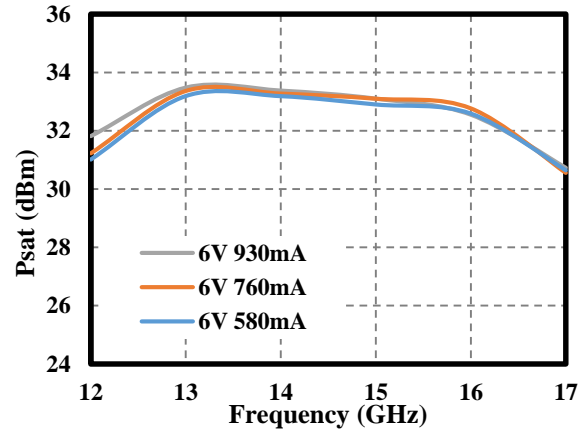


Figure 9. Psat vs. Id

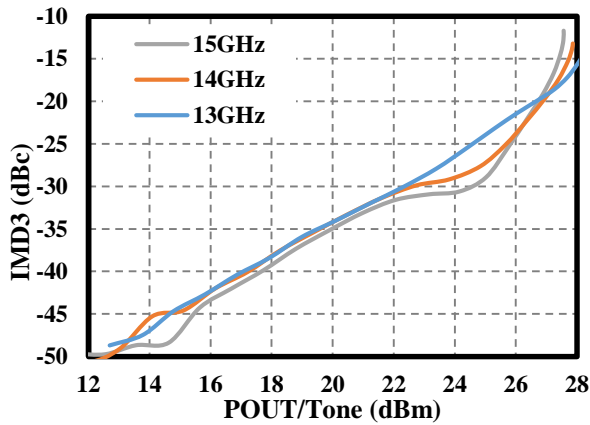


Figure 10. IMD3 vs. Pout/Tone

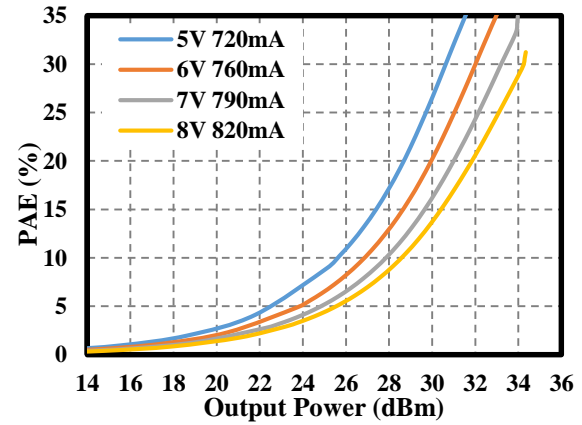


Figure 11. PAE vs. Pout @ 14GHz

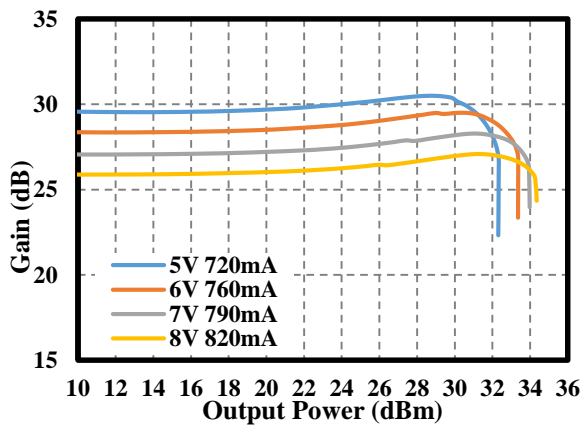


Figure 12. Gain vs. Pout @ 14GHz

3. 管脚信息

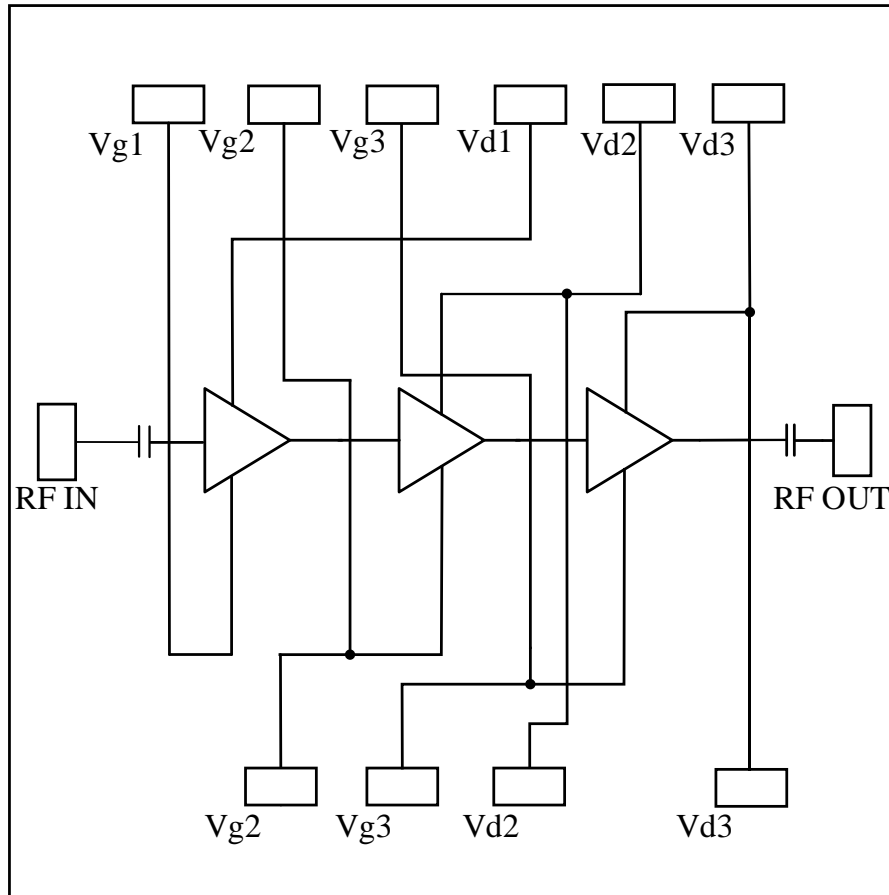


Figure 13. 管脚信息

Table 1. 管脚描述

管脚名	管脚描述
RF IN	射频信号输入端口
RF OUT	射频信号输出端口
Vg1,Vg2,Vg3	放大器的栅极电源电压
Vd1,Vd2,Vd3	放大器的漏极电源电压

4. 外形尺寸

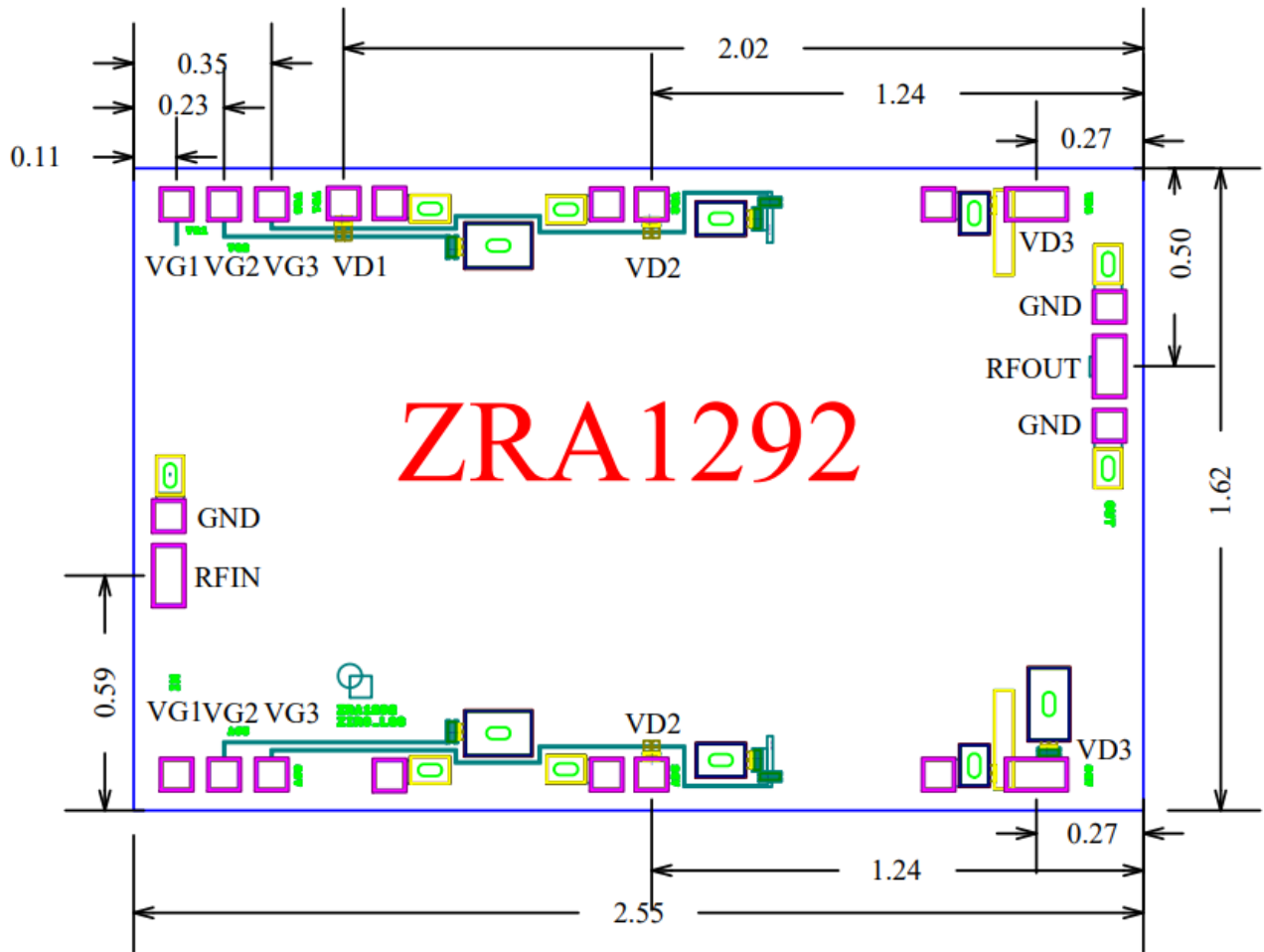


Figure 14. 外形尺寸

注:

1. 所有尺寸单位均为毫米;
2. 芯片厚度为 0.1mm;
3. 键合点金属为金;
4. 芯片背面镀金;
5. 芯片背面接地;
6. 外形尺寸公差为 $\pm 0.05\text{mm}$

5. 建议装配示意图

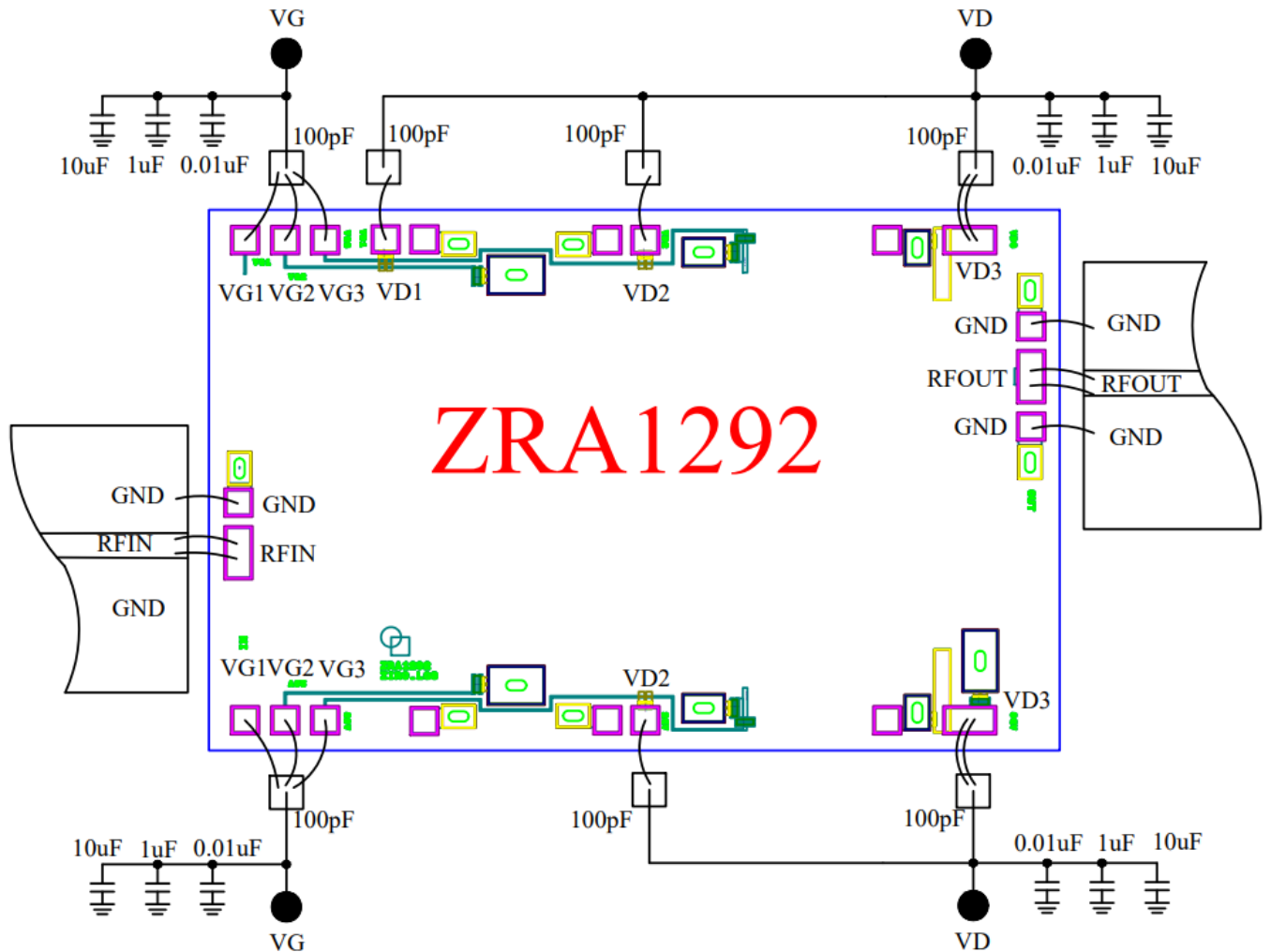


Figure 15. 装配示意图

注:

1. 须在净化间中进行装配;
2. 图中键合线为 25um 直径的金丝;
3. 射频键合点须键合 2 根金丝, 金丝长度尽量短。

6. 历史版本

Revision	Description	Modifier	Date
Rev.0.1	初始发布	YDS	2024.03.05